

InGaAs фотодиод 1654 нм, 1000 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIT3-1000B



ОСОБЕННОСТИ:

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ:

Детектирование в ближнем ИК-диапазоне

Мониторинг

Измерительные приборы

Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Чувствительность	R	$\lambda=1654\text{nm}, -5\text{V}$	0.9	1		А/Вт
Темновой ток	Id	VR=-5V			5.0	нА
Емкость	C	VR=-5V, f=1MHZ		55	65	пФ
Активная область	φ	-	995	1000	1005	мкм
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	Top	-40	85	°C
Температура хранения	Tstg	-40	125	°C
Прямой ток	IF	-	10	мА
Обратное напряжение	VR	0	20	В

Тип корпуса: TO46

Назначение выводов и габаритный чертёж

Тип соединения выводов (пинов)	
Вывод	Номер
1	PD+
2	PD-
3	GND

